

請求の範囲

- [請求項1] 複数の基板の積層体を形成して当該複数の基板の端面処理を行う際に、前記積層体中の隣り合う基板の間に介在させて、隣り合う基板同士を離間させるシート状のスペーサであって、
前記スペーサの面積は、前記基板よりも小さく、
前記スペーサを複数の前記基板の間に挟んで形成した積層体に対して、積層方向に圧力 0.6 MPa を加えた押圧状態から無押圧状態に圧力の解放をしたとき、前記圧力の解放によって変化する前記積層体の厚さから計算される前記スペーサ 1 枚あたりの厚さの変化量 ΔW は $30 \mu\text{m}$ 以下である、ことを特徴とするスペーサ。
- [請求項2] 前記スペーサは樹脂製である、請求項 1 に記載のスペーサ。
- [請求項3] 前記スペーサの表面粗さ R_a は $0.2 \mu\text{m}$ 以上である、請求項 1 又は 2 に記載のスペーサ。
- [請求項4] 前記スペーサは耐水性を有する、請求項 1 ～ 3 のいずれか 1 項に記載のスペーサ。
- [請求項5] 複数の基板と、当該複数の基板の隣り合う基板間に請求項 1 ～ 4 のいずれか 1 項に記載のスペーサを備えた、積層体。
- [請求項6] 請求項 5 に記載の積層体の側面の処理を含む、基板の製造方法。
- [請求項7] 請求項 5 に記載の基板の積層体の側面の処理を含む基板の製造方法であって、
前記積層体の側面の処理は、
前記積層体を押圧状態にする処理と、
前記押圧状態の前記積層体の側面を処理する第 1 側面処理と、
前記第 1 側面処理後、前記積層体の押圧状態を解放する処理と、
前記押圧状態を解放した前記積層体を 2 以上の積層体に分離すること、前記押圧状態を解放した前記積層体と他の積層体とを積層方向に結合すること、または前記押圧状態を解放した前記積層体をそのまま維持することのいずれかを行う中間処理と、

前記中間処理後、当該中間処理を行った前記積層体を押圧状態にする処理と、

前記中間処理後の前記押圧状態の前記積層体の側面をさらに処理する第2側面処理と、を含む基板の製造方法。

[請求項8] 前記基板はガラス板である、請求項6又は7に記載の基板の製造方法。

[請求項9] 磁気ディスク用基板の製造方法であって、
請求項6～8のいずれか1項に記載の基板の製造方法により、磁気ディスク用基板の素となる基板を製造する処理と、
前記積層体の側面の処理後の前記基板の主表面に、少なくとも研磨処理を行う後処理と、を備える、ことを特徴とする磁気ディスク用基板の製造方法。